

SEMI M53-0706

パターンのない半導体ウェーハ表面への単分散ポリスチレンラテックス球の堆積を使用した走査型表面検査システム校正の作業方法

NOTICE: This translation is a REFERENCE COPY ONLY. If differences should exist between the English version and a translation in any other language, the English version is the official and authoritative version.

免責事項： この SEMI スタンダードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

SEMI スタンダード日本語翻訳版をご利用にあたっての注釈を本文の末尾に記載しております(「すべきである」「しなければならない」について等)。

本仕様は、Silicon Wafer Global Technical Committee で技術的に承認されている。現版は 2006 年 5 月 16 日、global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2006 年 6 月に www.semi.org で。初版は 2003 年 3 月発行。前版は 2006 年 3 月発行。

1 目的

- 1.1 この作業方法では、パターンのない鏡面、エピタキシャル、薄膜生成された半導体表面上に堆積された PSL 球のサイズを SSIS が正確に決定できるように、SSIS の暗視野チャンネルの校正について記述する(関連情報 1 を参照)。
- 1.2 この作業方法では、アイデンティティおよび真のサイズが未知の実際の表面欠陥を報告する手段としてのラテックス球等量 (LSE) の使用方法を定義する。
- 1.3 この作業方法では、感度、再現性、キャプチャレート等のパラメータが懸念される関連スタンダードで使用されるように SSIS の性能を定量化するための基礎を提供する。

2 範囲

- 2.1 この作業方法では、次の事項をカバーする。
 - 2.1.1 基準ウェーハを形成するために PSL 球が堆積される半導体ウェーハ基板の表面およびその他の特性に対する要求条件 (¶ 8.1 を参照)。
 - 2.1.2 PSL 球の堆積が満たさなければならないサイズ分布の要求条件も含め、SSIS を校正するための PSL 球の適切で証明済み堆積の選択。ただし、堆積方法は含まれない (¶ 8.2 を参照)。
 - 2.1.3 応答曲線の変動があるが故に単調ではない、モデルで予測した散乱データを使用した校正曲線の生成。
 - 2.1.4 モデルで予測した散乱データを使用した単調な校正曲線の生成。
- 2.2 これは、主として SEMI M1 で指定されている幾何学的特性を有する研磨シリコンウェーハ局所的散乱体 (LLS) の検出に使用される SSIS の校正に使用するために開発されたが、適切な基準ウェーハが採用されるという条件で、この作業方法はパターンのない他の半導体表面の LLS の検出に使用される SSIS にも適用できる。
- 2.3 この作業方法は、LSE 値を使用して PSL 球以外の LLS のサイズを決定する方法を定義する意図はまったくない (¶ 3.1 を参照)。

2.4 この作業方法は、SEMI M52 に記載されている要求条件をサポートする。

2.5 付属書 1 では、限定された生産用途に使用できるシングルポイント校正について説明するが、SEMI M52 に記載されている要求条件はサポートしていない。

注意： このスタンダードおよび安全ガイドラインはその使用に関連した全ての安全上の問題を取り扱うことを意図していない。この文書の使用者は、その責任において、適切な安全および健康上実施すべき事項を決定し、また使用前に法規制やその他の制限への適用性を判断するものである。

3 制限

3.1 LLS に対する SSIS の応答は、SSIS の光学システム特性、LLS のサイズ、形状、向き、構成によって異なるので、LLS は、通常は LSE サイズのみを割り当てるものであって、物理的な直径を割り当てるものではない。異なる SSIS の光学システム特性は異なるので、PSL 球に対して校正された SSIS によって特定の LLS に割り当てられる LSE サイズは、同様に校正された異なるモデルの別の SSIS によって同じ LLS に割り当てられる LSE サイズと異なる可能性がある。

3.2 堆積システムの伝達関数に起因して、まとめて販売される PSL 球には、堆積の結果として得られる特性とは著しく異なる仕様特性（平均直径の不確実性、直径の分布、平均直径およびモード直径の間の広がり）を有している可能性がある。この理由により、この作業方法は、適切に特性評価された PSL 球堆積を使用する場合に限定される（¶ 8.4 参照）。

3.3 この作業方法で使用する最大の PSL 球の直径は、個々の SSIS 特性に依存するが、しばしば光源の波長の約 10 倍の直径に制限される。

3.4 直径の小さい方の制限は、校正する SSIS の感度によって課せられる。

注 1: この作業方法のこの版の作成時には、堆積される実際の PSL 球の直径は 30 nm に近いが、IC テクノロジーのクリティカルな寸法はますます小さくなっていくので、より小さな直径の PSL 球の体積が提供されるようになると予測される。

3.5 単調応答曲線を使用し、かつ校正対象のチャンネルのダイナミックレンジが、単調ではない応答曲線に応答曲線の変動がある領域に及ぶ場合は、その領域では PSL 球のサイズを決定する精度は低下する。

3.6 背景汚染

3.6.1 堆積プロセスと校正作業は、両方とも ISO 14644-1 で定義されているクラス 4 以上の環境で実行しなければならない。

注 2: ISO のクラス 4 は、連邦規格 209E で定義されているクラス M2.5 (クラス 10) とほぼ同じである。

3.6.2 基準ウェーハ上に基準 PSL 直径の局所的な光散乱体に近い LSE サイズの汚染が存在すると、結果が不正になる可能性がある。この状態になると、大きな誤差を生じたり、サイズ決定の精度が低下する可能性がある。

3.6.3 基準ウェーハまたはウェーハ上の汚染が高レベルである場合、SSIS が過負荷になったり、堆積 PSL 球の直径の分布のピークが不明確になることがある。この状態でも、大きな誤差を生じたり、等価サイズ決定の精度が低下する可能性がある。

3.6.4 これらの理由により、堆積プロセスおよび構成手順は両方法ともクリーンな環境で実行しなければならない。基準ウェーハは、堆積プロセスと校正の間で汚染を生じない方法で取り扱わなければならない。

3.7 基準ウェーハまたはウェーハの表面粗度が大きい場合、PSL 球分布のピークが不明確になったり、歪む可能性がある。

3.8 校正する SSIS が安定に動作していない場合、校正を実行してもその後のシステムの使用に当たって適切でなくなる可能性がある。適切な期間にわたりこの作業方法に従って校正を繰り返すことによってシステムの安定性を評価できる。

4 参照スタンダードおよび文書

4.1 SEMI スタンダード

SEMI M1 — Specifications for Polished Monocrystalline Silicon Wafers

SEMI M12 — Specification for Serial Alphanumeric Marking of the Front Surface of Wafers

SEMI M20 — Practice for Establishing a Wafer Coordinate System

SEMI M50 — Test Method for Determining Capture Rate and False Count Rate for Surface Scanning Inspection Systems by the Overlay Method

SEMI M52 — Guide for Specifying Scanning Surface Inspection Systems for Silicon Wafers for the 130-nm, 90-nm, 65-nm, and 45-nm Technology Generations

SEMI M58 — Test Method for Evaluating DMA Based Particle Deposition Systems and Processes

SEMI M59 — Terminology for Silicon Technology

4.2 Federal スタンダード¹

Fed Std 209E — Airborne Particulate Cleanliness Classes in Cleanrooms and Clean Zones

4.3 ISO スタンダード²

ISO 14644-1 Cleanrooms and Associated Controlled Environments — Part 1: Classification of Airborne Particulates

注意： 別途指示のない場合、引用された全ての文書は最新版を指す。

5 用語

5.1 略語および頭字語

5.1.1 CR (*capture rate*) — 捕獲率

5.1.2 CV (*coefficient of variation*) — 変動係数

5.1.3 GNF (*gain-nonlinearity function*) — 利得非線形関数

5.1.4 LLS (*localized light scatterer*) — 局所的光散乱体

5.1.5 LSE (*latex sphere equivalent*) — ラテックス球等量

5.1.6 MPRC (*monotonic predicted response curve*) — 単調予測応答曲線

5.1.7 MRC (*monotonic response curve*) — 単調応答曲線

5.1.8 PRC (*predicted response curve*) — 予測応答曲線

5.1.9 PSL — polystyrene latex

5.1.10 RC (*response curve*) — 応答曲線

5.1.11 SSIS (*scanning surface inspection system*) — 走査型表面検査システム

5.2 用語の定義

5.2.1 シリコンテクノロジーの一般用語の定義は、SEMI M59 に記載されている。

¹ Standardization Documents Order Desk, Bldg. 4 Section D, 700 Robbins Ave., Philadelphia, PA 19111-5094, Attn: NPODS
(本スタンダードは、ISO 14644-1と入れ替ったので、使用できない。)

² International Organization for Standardization, ISO Central Secretariat, 1, ch. de la Voie-Creuse, CP 56, CH-1211 Geneva 20, Switzerland;
Telephone: +41.22.749.01.11, Fax: +41.22.733.34.30, <http://www.iso.org>

5.2.2 その他の定義

5.2.2.1 校正直径誤差 (calibration diameter error) — RC および証明済み堆積直径の間の偏差。

5.2.2.2 捕獲率 (capture rate [CR]) — 走査型表面検査システム (SSIS) が何らかの指定された SSIS 動作設定でラテックス球等量 (LSE) の局所的散乱体 (LLS) の信号値を検出できる確率。

5.2.2.3 証明済み堆積 (certified deposition) — 技術的に有効な手順によって証明された特定の正しい値を有する校正された SSIS によって検査されるウェーハと同じ表面薄膜および仕上げを有するパターンのないウェーハ上の PSL 球の堆積であって、認証機関によって発行された証明書が付属している、あるいはそれを追跡可能な PSL 球の堆積。

5.2.2.4 議論 — 保証しなければならない堆積特性値は、球の直径のピーク値、ウェーハ上の直径の分布であり、PSL 球のソースおよび堆積プロセスの両方によって決定される。

5.2.2.5 変動係数 (coefficient of variation [CV]) — ガウス分布の平均値に対するパーセント値として表現される 1 つの標準偏差 σ 。

5.2.2.6 堆積 (deposition) — 基準ウェーハ上の既知の位置に配置された、ほぼ既知の数の既知のサイズ分布の PSL 球。

5.2.2.7 堆積プロセス (deposition process) — PSL 球を基準ウェーハ上に配置するために使用される手順。

5.2.2.8 ダイナミックレンジ (dynamic range) — 走査型表面検査システムの測定条件の集合の 1 つにより測定器によってカバーされる信号の範囲。

5.2.2.9 議論 — 役に立つダイナミックレンジは、背景雑音や計測器の本質的な分解能によって信号の小さい側に限定されるか、検出器や関連電子回路の飽和によって信号の大きい側に限定される。小さな信号の限界は、通常、少なくとも 95% の捕獲率で測定できる最小の PSL 球の直径として定義される。

5.2.2.10 偽計数 (false count) — ウェーハ表面上または近傍の特性ではなく、計器類から生じるレーザ光散乱現象。また、正の偽計数と称され、妨害計数と比較される。

5.2.2.11 議論 — 偽計数は、複数検査スキャン中にウェーハ表面上の同じ位置で偽計数が発生することはない。したがって、それらは、反復スキャンの結果を評価することにより確認できるランダム「ノイズ」と見なすことができる。

5.2.2.12 利得非線形関数 (gain-nonlinearity function [GNF]) — SSIS の実際の応答とモデルで予測した SSIS の応答の間の関係であって、複数の独立パラメータおよび調整可能なパラメータを有する関数として与えられる。

5.2.2.13 ヒストグラム (histogram) — 区分された (ビン分けされた) データセットをバークラフで表現したもの。バーの幅はデータセット変数のビンのサイズに比例し、バーの高さは変数の値がそのビンに入る頻度に比例する。

5.2.2.13.1 議論 — LSE のサイズ分布のデータを表現する場合、データセット変数は通常は導出された LLS サイズであり、ヘイズを表現する場合はデータセット変数は通常は ppm で表したヘイズである。通常、データセットは、必要に応じてリニアまたは対数スケールの等しいサイズのビンに区分される。データセット変数の範囲の低い方の端と高い方の端のビンは、残りのビンよりも大きいあるいは小さい独立変数の範囲を表現できるとしても、慣習的にヒストグラムの残りの部分と同じ幅でプロットされる。

5.2.2.14 レーザ光散乱現象 (laser-light scattering event) — 設定済みの強度しきい値を超える信号パルス。ウェーハ表面の LLS とレーザが相互作用して生成され、検出器によって検出される。

5.2.2.14.1 議論 — 入射ビーム方向と集光部の任意の組み合わせで測定され、単一の検出器に入る信号強度は、例えば LLS がピットであれパーティクルであれ、それ自体は形状に関する情報を含まない。観察者は、屈折率や形状等の他の詳細事項を知らなければ散乱のサイズや出所を推論できない。走査型表面

検査システムでは、レーザ光散乱現象およびヘイズに起因する背景信号が一緒になってウェーハ表面からの光散乱に起因する信号を構成する。

5.2.2.15 ラテックス球等量 (*latex sphere equivalent (LSE)*) — 同じテスト条件で、調査対象の LLS と同じ検出散乱強度が生じる単分散ポリスチレンラテックス球に関連する。

5.2.2.15.1 議論 — LLS がパーティクル（またはピット）に起因するものであると仮定すると、パーティクル（またはピット）の LSE サイズ（直径）は長さの単位の後に LSE を付けて与えられ、例えば ‘0.12 μm , LSE’ となる。異なる計測器では光学システムおよび信号の処理手順が異なるので、異なる材料については単位はいろいろな状況で異なってくる。したがって、特定の LLS を異なったモデルの計測器や同じ計測器の異なるチャンネルで測定すると、一般に同じ LSE サイズにならない。入射角度、集光立体角、偏光等、SSIS の光学システムのエレメントが変化し得る場合、特定の LLS の LSE サイズは、光学システムの各構成について必ずしも同じにはならない。

5.2.2.16 局所的散乱体 (*localized light scatterer [LLS]*) — ウェーハ表面上または表面内にあるパーティクルやピット等の孤立した形状。取り囲んでいるウェーハ表面に対して光散乱強度が高くなる。高強度の光で照明された十分なサイズの形状は孤立した光の点に見えるので歴史的に光点欠陥と呼ばれる。

5.2.2.16.1 議論 — 局所的散乱体は、レーザ光散乱現象のような自動検査手法によって観察される。異なる散乱強度を有する散乱体を分離できるという意味で自動検査手法は定量的な手法である。しかし、入射ビームの方向および集光部の任意の組み合わせによって測定される散乱光強度の大きさあるいは「レーザ光散乱現象」それ自体は、LLS に関する形状情報は運ばず、単一チャンネルの強度データだけではパーティクルとピットを区別できない。また、単一チャンネルの強度データだけでは観察者は LLS のサイズ、形状、構成を推論できない。LLS の存在によって、ウェーハの使用率が必ずしも低下するわけではない。

5.2.2.17 消失計数 (*missing count*) — LLS がレーザ光散乱現象を起こさなかった場合。負の偽計数とも呼ばれる。

5.2.2.18 単調予測応答曲線 (*monotonic predicted response curve [MPRC]*) — PRC から導かれ、単調になるように修正された予測応答曲線。

5.2.2.18.1 議論 — MPRC は、小さな直径の領域では PRC と同じであり、より大きな直径では PRC の応答曲線の変動は除去される。MPRC は、例えば、PRC の移動平均、あるいは適切な制限挙動（例えば、小さな直径では $\sim D^6$ 、大きな直径では $\sim D^2$ ）を有する関数への回帰、あるいは現実のパーティクルの集合に対するモデル化された平均応答でもよい。MPRC は、同じ SSIS モデルが同じ MPRC を有するように、SSIS のメーカーが作成しなければならない。

5.2.2.19 単調応答曲線 (*monotonic response curve [MRC]*) — SSIS の実際の信号と LSE 直径の間の単調な関係。PRC ではなく MPRC から導かれるので RC とは異なる。

5.2.2.20 妨害計数 (*nuisance count*) — 調査中の局所的散乱体ではなく、分離したあるいは面のあるいは面に近い形状から起こる信号パルス。偽計数と比較すること。

5.2.2.20.1 議論 — 妨害計数の存在は、しきい値とゲインの設定に依存し、SSIS の光学系の構成、ウェーハ表面の方位、あるいはその両方の関数である可能性がある。

5.2.2.21 ポリスチレンラテックス (*polystyrene latex [PSL]*) — 保証された堆積物が生成される、ポリスチレン微小球のコロイド水溶液。

5.2.2.22 予測応答曲線 (*predicted response curve [PRC]*) — 散乱光の強度（または SSIS の信号応答）と、さまざまな PSL 球の直径近傍でスキヤナの応答を分析するために使用される PSL 球の直径の間のモデルで予測した関係。PRC は、スキヤナの設計に依存し、一般に非線形である。応答と直径の関係が複数の値になる応答曲線の変動がある領域が含まれることがある。